



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

## 一种光响应敏感的电化铋薄膜和硅基片形成的PN结材料

文献类型: 专利

**作者** 王振华; 张志东; 李名泽; 杨亮; 赵晓天; 高翔

**发表日期** 2019-02-12

**专利号** 201610183745.5

**著作权人** 王振华; 张志东; 李名泽; 杨亮; 赵晓天; 高翔

**国家** 中国

**文献子类** 发明专利

**源URL** [http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/158304]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**作者单位** 中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 王振华; 张志东; 李名泽; 杨亮; 赵晓天; 高翔. 一种光响应敏感的电化铋薄膜和硅基片形成的PN结材料.

**GB/T 7714** 201610183745.5. 2019-02-12.

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

2

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。